证券代码：688138　　证券简称：清溢光电　　公告编号：2026-033

深圳清溢光电股份有限公司

关于控股子公司投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期（以下简称“本项目”或“第三期项目”）
- **投资金额：**第三期项目计划总投资额不超过人民币 15 亿元，包括设备采购费、装修费等，最终投资总额以项目建设实际投资为准。
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本项目已经公司董事会战略委员会、董事会审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》等规定，无需提交股东会审议。本项目尚需履行项目备案、环境影响评价等行政审批手续。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

（一）本项目尚需履行项目备案、环境影响评价等行政审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

（二）本项目的资金来源为公司控股子公司佛山清溢微电子有限公司的自有或自筹资金。本项目预计投入资金较大，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。在项目实施过程中，相关资金筹措情况存在不确定性。

（三）本项目是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。新建项目具有一定的建设周期，在项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目产能过剩及收益不达预期的风险。

（四）本项目涉及的投资金额等数值均为预估数，公司将根据实际情况审慎投资，逐步拓展，实际投资金额存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资

风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

2023 年 8 月，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“清溢光电”或“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于拟对外投资暨签署合作协议的公告》（公告编号：2023-018），清溢光电拟在佛山市南海区投资人民币 35 亿元建设佛山生产基地项目，其中“高端半导体掩膜版生产基地建设项目”分三期建设，合计拟投资人民币 15 亿元，其中一期拟投资人民币 6.05 亿元，二期拟投资人民币 2.95 亿元，三期拟投资人民币 6 亿元。实施主体为佛山清溢微电子有限公司（以下简称“佛山清溢微”，更名前为“广州清溢微电子有限公司”）。前述事项已经公司董事会、股东会审议通过。

目前“高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”已顺利投产，“高端半导体掩膜版生产基地建设项目二期”正稳步推进中。为抢抓半导体产业国产替代战略机遇，落地公司高端制造、国产替代核心发展战略，补齐高端半导体掩膜版产能缺口，巩固半导体掩膜版国产替代核心竞争力，公司控股子公司佛山清溢微拟在现有高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期、二期基础上投资建设“高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期”，第三期项目计划总投资额不超过人民币 15 亿元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例　□非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司　□控股子公司　□参股公司　□未持股公司 □投资新项目 ☑其他：高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期（在现有高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期、二期基础上扩建）
投资标的名称	高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期
投资金额	☑ 已确定，具体金额（人民币万元）：不超过 150,000 □ 尚未确定

出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☐募集资金 ☑银行贷款 ☑其他：自筹资金 ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____
是否跨境	☐是 ☑否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2026 年 11 月 9 日，公司召开第十届董事会战略委员会第一次会议、第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设项目的议案》，同意公司控股子公司佛山清溢微投资建设高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期，第三期项目计划总投资额不超过人民币 15 亿元。

本次投资建设事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司法定代表人、董事长唐英敏女士或其指定的授权代理人签署对外投资事项下相关协议、合同等，并办理本次投资的全部后续事项。

本项目尚需履行项目备案、环境影响评价等行政审批手续。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资建设事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

（一）投资项目概况

公司控股子公司佛山清溢微拟作为项目实施主体，在现有高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期、二期的基础上，投资建设高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期，第三期项目计划总投资额不超过人民币 15 亿元，包括设备采购费、装修费等，最终投资总额以项目建设实际投资为准。

（二）投资项目具体信息

1、项目基本情况

投资类型	☑其他：高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期（在现有高端半导体掩膜版生产基地建设项目一

	期、二期基础上扩建）
项目名称	高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期
项目主要内容	在佛山清溢微现有厂房基础上改造并引入新设备扩建生产线，主要产品为覆盖 28nm-14nm 制程的高端半导体掩膜版。
建设地点	佛山市南海区丹灶镇丹凤路 6 号
项目总投资金额（万元）	第三期项目计划总投资额不超过人民币 150,000 万元，包括设备采购费、装修费等，最终投资总额以项目建设实际投资为准。
上市公司投资金额（万元）	0
项目建设期（月）	36
预计开工时间	2026 年 12 月
预计投资收益率	/
是否属于主营业务范围	☑是 □否

2、各主要投资方出资情况

本项目拟由佛山清溢微投资运营和管理，第三期项目计划总投资额不超过人民币 15 亿元（最终投资总额以项目建设实际投资为准），资金来源为控股子公司佛山清溢微的自有或自筹资金。

3、项目目前进展情况

本项目尚未完成项目备案、环境影响评价等审批，审批结果存在不确定性。

4、项目市场定位及可行性分析

（1）项目市场定位

本项目定位为面向国内先进制程晶圆制造环节的高端半导体掩膜版本土化配套产能，聚焦 28nm-14nm 节点掩膜版产品供给，承接国内晶圆厂扩产及制程升级带来的掩膜版增量需求，有助于补齐国内先进制程掩膜版供给短板；依托本土交付、快速技术协同、稳定保供优势，服务国内芯片设计与制造产业链，提升先进节点掩膜版自主供给能力，成为国内先进制程掩膜版国产替代的重要供应商。

（2）可行性分析

在 AI 算力、高性能计算、高端终端需求持续拉动下，国内晶圆制造制程持续往更加先进的方向发展，对应掩膜版需求持续增长，28nm-14nm 项目产能规划与下游晶圆制造的配套需求相匹配，具备较好的市场需求基础，具备明确的长期战略价值与成长空间。当前国内先进制程掩膜版国产化率偏低，市场供给较多依

赖境外厂商，供应链存在交付周期、价格、合规保供等风险，本项目契合产业链国产替代的长期趋势。

公司已实现 55nm 掩膜版制程节点技术突破，积累了掩膜版核心工艺、材料、检测等技术经验，同时沉淀了较为成熟的研发、工艺及生产人才团队；以现有技术平台为基础向 28nm-14nm 节点掩膜版迭代，技术路线具备连贯性，人才储备可复用，并通过后续关键工艺攻关、设备配置及客户验证，降低先进制程研发落地风险，为项目实施提供核心能力保障。

（三）出资方式及相关情况

本项目建设出资方式为现金出资，资金来源为佛山清溢微的自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对公司的影响

本项目建设完成后，可提高公司半导体掩膜版产品的技术能力和产能，优化公司半导体掩膜版的产品结构，提升技术和工艺水平，提升公司在半导体掩膜版市场占有率。

四、对外投资的风险提示

（一）本项目尚需履行项目备案、环境影响评价等行政审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

（二）本项目的资金来源为佛山清溢微的自有或自筹资金。本项目预计投入资金较大，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。在项目实施过程中，相关资金筹措情况存在不确定性。

（三）本项目是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。新建项目具有一定的建设周期，在项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目产能过剩及收益不达预期的风险。

（四）本投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数，公司将根据实际情况审慎投资，逐步拓展，实际投资金额存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日